

Кремниевый PIN фотодетекторный чип 660×660 мкм — техническое описание

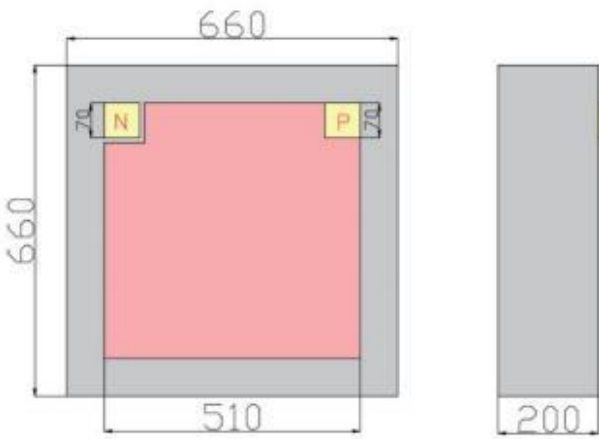
P/N : WS9H-01C

Применение

Si PIN фотодиодный чип

Структура

Планарная структура: PIN-диод; электроды: верхняя сторона (катод) — Al, верхняя сторона (анод) — Al



ГАБАРИТЫ

Габариты	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Активная область	510 x 510±15			мкм
Ширина чипа	660±25			мкм
Длина чипа	660±25			мкм
Высота чипа	180	200	220	мкм
Контактная площадка катода		70		мкм
Контактная площадка анода		70		мкм

Электрооптические характеристики (при Ta=25 °C)

Параметр	Обозначение	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Прямое напряжение	Vf	If=10mA, H =0	0.5		1.3	В
Обратное напряжение	V br	Ir =100μA, H =0	35			В
Обратный темновой ток	Id	Vr =10V			10	нА
Рабочий диапазон длин волн	λр		400	940	1100	нм
Емкость	Cj	VR =3V, f=1MHz		8		пФ